[Article]

May

www.whxb.pku.edu.cn

吸附相反应技术制备 TiO2 的结晶过程以及光降解气相甲苯

王挺 蒋 新* 吴艳香

(浙江大学材料与化工学院,杭州 310027)

摘要: 研究了吸附相反应技术制备纳米 TiO₂的结晶过程,并探讨了该过程对 TiO₂ 光催化活性的影响.利用 XRD 测定了不同温度和时间焙烧后 TiO₂ 的晶型以及晶粒粒径的变化,发现即使焙烧温度高达 900 ℃, TiO₂ 仍 维持纯锐钛矿晶型.随着焙烧温度的增加, TiO₂ 的晶粒粒径变化不大,均在 7 nm 以下,在焙烧温度高于 700 ℃ 时,锐钛矿结晶峰的峰面积随温度增加,峰面积保持不变.改变焙烧时间基本不影响 TiO₂ 的晶型和晶粒粒径,因 而其光催化活性变化也较小.光降解气相甲苯实验表明,700 ℃焙烧后样品的催化活性最高,且优于商用 P25 光 催化剂.

关键词: 吸附相反应技术; 纳米 TiO₂; 结晶; 光降解 中图分类号: O647; TQ03

Crystallization of Nano TiO₂ Prepared by Adsorption Phase Reaction Technique and Photo-degradation of Gaseous Toluene

WANG Ting JIANG Xin* WU Yan-Xiang

(College of Material and Chemical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, P. R. China)

Abstract: The crystallization of nano TiO₂ prepared by adsorption phase reaction technique and the influence of crystallization on photo-catalytic activity of TiO₂ were explored. XRD was employed to study the change of crystalline form and gain size of TiO₂ under different sintering temperatures and times. The results indicated that there was also pure anatase TiO₂ in samples, even when the sintering temperature reached 900 $^{\circ}$ C. With increase of sintering temperature, grain size of TiO₂ was below 7 nm and changed little. Whereas the peak area of anatase TiO₂ increased with sintering temperature and remained unchanged when temperature reached 700 $^{\circ}$ C. However change of sintering time influenced little on crystalline form and grain size of TiO₂, so its photo-catalytic activity also changed little with sintering time increasing. Photo-degradation of gaseous toluene indicated that the sample sintered under 700 $^{\circ}$ C had the highest photo-catalytic activity and its activity was better than P25.

Key Words: Adsorption phase reaction technique; Nano TiO₂; Crystallization; Photo-degradation

随着人们对环境问题的日益关注,利用半导体 光催化剂去除挥发性有机污染物(volatile organic compounds, VOCs)已经成为目前环境治理中的热 点^[12].由于高效和无二次污染等特点,纳米TiO₂成为 目前最引人注目的半导体光催化剂^[3-5].通常纳米 TiO₂的粒子粒径越小,其催化性能越高,如当粒子 粒径从 16 nm 减少至8 nm 之后,其光催化活性可以 提高 6 倍多⁶⁰. 为了得到稳定的小粒径粒子, 提出了 多种新型的制备方法. 其中吸附相反应技术(吸附 法)由于能简便有效地控制粒子粒径, 而具有广泛 的应用前景.

吸附相反应是微反应器制备技术的一种,它利 用固体表面吸附层作为反应器以及纳米粒子生成场 所,可以通过改变实验条件来改变吸附层的形貌,从

国家自然科学基金(20776126 和 20476088)资助项目

© Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica

Received: December 29, 2007; Revised: February 21, 2008; Published on Web: April 2, 2008.

^{*}Corresponding author. Email: jiangx@zju.edu.cn; Tel: +86571-87952828.

而非常简便地对粒子形貌进行调控. Dekany 等^[7,8]首 先利用吸附相反应技术在载体表面原位制备了多 种纳米材料, 如 Pd、CdS 等. 在我们前期工作中^[9,10], 就利用该技术在 SiO₂ 表面制备了粒径在 2-7 nm 的 纳米 TiO₂ 粒子. 通过比较浸渍法的结果, 发现吸附 相反应技术得到的 TiO₂ 粒子粒径小、分散性好. 这 些优异的性能使得利用吸附相反应技术得到的纳米 TiO₂ 的光催化活性要远远高于浸渍法得到的纳米 粒子^[11].

除了粒子粒径之外,影响纳米 TiO₂ 光催化活性 的另一个重要因素就是晶型.一般认为锐钛矿晶型 的 TiO₂ 具有较高催化活性^[12,13],而 TiO₂ 结晶以及晶 型转变都与热处理条件有较大关系.本文在前期工 作的基础上^[11],选择了光催化降解甲基橙反应,在活 性最高催化剂的制备条件下,进一步设计了不同焙 烧温度和焙烧时间实验.研究吸附相反应技术(adsorption phase reaction technique, APRT) 得到 TiO₂ 在不同焙烧条件下的结晶过程,并结合对甲苯的气 相光降解来考评 TiO₂ 结晶过程的变化对其光催化 活性的影响.

1 实验部分

1.1 实验试剂与分析仪器

实验试剂: 二氧化硅, 平均粒径12 nm, 比表面积 200 m²·g⁻¹(Degussa公司 AEROSIL200); 钛酸丁酯, 分 析纯(常州蓝天化工厂); 无水乙醇, 分析纯,(上海试剂 一厂); 甲苯, 分析纯(杭州化学试剂有限公司).

分析仪器:用 D/max-rA 转靶 X 射线多晶衍射 仪(X-ray diffraction, XRD)测定 TiO₂ 晶型和晶粒粒 径. AUTOSORB-1-C 气体吸附仪测定光催化剂的比 表面积. GC9790a 气相色谱 (毛细管色谱柱, ATOV-225)测定光降解实验中甲苯的含量.

1.2 吸附相反应法制备 TiO₂

取0.5g亲水性、大比表面积的纳米级载体 SiO₂, 200 mL 无水乙醇和 1.5 mL 去离子水置于三口烧瓶 中,在不同温度下搅拌吸附、反应.由于 SiO₂的选择 性吸附作用,其表面逐渐形成富含水的吸附层(如图 1). 在吸附 12 h 达到平衡后,另取 50 mL 乙醇加入 2.15 g 的钛酸丁酯,把该钛酸丁酯的乙醇溶液滴加 到已经达到吸附平衡的体系中,钛酸丁酯通过扩散 作用到达 SiO₂ 表面,在吸附水层中发生水解、缩聚 反应,反应一定时间后,经过多次离心、再分散、洗涤 以及烘干后,在各个温度下焙烧后得到样品.



图 1 低水溶液浓度下吸附法制备纳米 TiO₂ 原理示意图 Fig.1 Scheme of preparation of TiO₂ in adsorption layer at low aqueous solution concentration



1.3 光催化实验

将一定量的催化剂分散于溶剂中后,均匀地涂 覆在平板表面.然后放入烘箱(120℃)烘干除去溶剂.

将烘干后的涂覆了光催化剂的平板放入自制聚 四氟乙烯反应器(15 W, 254 nm 紫外光源,反应器体 积 52.2 dm³,见图 2),并注入定量的甲苯饱和蒸汽, 在风扇的搅拌下,当暗态吸附达到平衡后打开紫外 光源进行光催化降解反应,间隔一定时间取样,利用 GC 测定甲苯的含量.降解完成后由甲苯含量变化 曲线计算得到反应速率常数.在相同条件下,仅加入 载体 SiO₂进行光催化空白实验,以扣除空白实验的 影响.

本文着眼于一定光照强度下的催化动力学,为 避免催化剂分布不均出现空白表面,首先进行了催 化剂用量实验,确定了最低的催化剂用量(即在该用 量以上,动力学常数不随催化剂用量而改变).所有 实验(除 P25 催化剂以外)均在该用量以上进行.

2 结果和讨论

2.1 焙烧温度实验

2.1.1 焙烧温度对 TiO2 晶型和晶粒粒径的影响



图 2 光催化反应装置图 Fig.2 Scheme of photocatalysis reactor



图 3 样品在不同温度焙烧后的 XRD 图 Fig.3 XRD patterns of samples after sintering at different temperatures

由 TiO₂的结晶过程研究可知, 焙烧温度是 TiO₂ 结晶过程以及晶型变化的关键因素之一. 而在前期 工作中, 作者发现 TiO₂ 晶型的变化对其光催化活性 有一定的影响. 为了进一步研究 TiO₂ 的结晶过程以 及晶型变化对其催化活性的影响, 作者在不同的温 度焙烧 1.5 mL 水量的吸附法样品^[11], 得到各个温度 焙烧 5 h 后样品的 XRD 图(图 3)

由图 3 可以看出, 当焙烧温度为 300 ℃时, 吸附 法得到的 TiO₂ 不能形成晶型, 仍保持无定型状态. 其他三个温度焙烧后的 TiO₂ 都是纯锐钛矿型, 没有 出现金红石型. 随着焙烧温度的增加, 结晶峰变得更 加明显, 尤其当焙烧温度从 500 ℃升高至 700 ℃时.

根据 TiO₂ 结晶过程的文献^[14,15],单一纳米 TiO₂ 粒子在 300-400 ℃,甚至 300 ℃以下焙烧 2 h 后, XRD 图谱中就已经出现非常明显的锐钛矿 TiO₂ 的 结晶峰,这就说明单一纳米 TiO₂ 比实验得到的 TiO₂ 复合材料更容易形成晶型. 文献中还指出,当焙烧温 度升高到 450 ℃以上时,锐钛矿型的 TiO₂ 就逐渐向 金红石型转变,在焙烧温度超过 600 ℃,锐钛矿型 TiO₂ 就会基本消失. 在前期工作中^[11],作者也发现 500 ℃焙烧 5 h 时, 1.5 mL 水量的浸渍法样品中就 出现了较明显的金红石型 TiO₂. 而在图 3 中,即使 焙烧温度高达 900 ℃,吸附法得到的样品中仍维持 纯锐钛矿型的 TiO₂.

结合纳米 TiO₂ 复合材料的研究, 作者认为这是 由于纳米SiO₂的网络结构对其表面生成的TiO₂结晶 过程的阻碍^[16,17], 从而使得吸附法样品中纳米 TiO₂ 在 300 ℃焙烧后, 仍能维持或基本保持无定型结构. 另外, SiO₂ 的这种网络结构不但增加了 TiO₂ 形成晶 体的难度, 还能阻碍锐钛矿型 TiO₂ 向金红石型的转

表 1 不同温度焙烧后 TiO2 晶粒粒径							
Table 1Grain size of TiO2 after sintering atdifferent temperatures							
T/℃	300	500	700	900			
<i>d</i> /nm	-	5.20	6.16	7.36			

变.而且由于吸附法采用 SiO₂ 表面的吸附层作为反应和纳米 TiO₂ 粒子生长的场所,样品中 Si 和 Ti 以 Si-O-Ti 等化学键形式稳定地结合在一起,因此 SiO₂ 的网络结构对吸附法得到的 TiO₂ 的作用更稳定更强烈,即使焙烧温度高达 900 ℃,焙烧 5 h 后得到的纳米 TiO₂ 仍是纯的锐钛矿型.

拟合XRD谱图中2*θ*=48°峰高的锐钛矿峰得到半高宽,然后按照Scherrer公式来计算晶粒的平均粒径.表1为TiO₂经过各个温度焙烧后的晶粒粒径.

从表 1 中的数据可以发现, 在较苛刻的焙烧条 件下, 吸附法得到的 TiO₂ 的晶粒粒径仍能维持在 10 nm 以下, 而前期工作^{□□}中仅 700 ℃焙烧后浸渍法 TiO₂ 的晶粒粒径就达到了 70 nm. 这就说明了, 吸附 法载体表面吸附层作为粒子生长场所抑制了粒子的 生长, 得到的高分散、小粒径的纳米 TiO₂ 粒子. 同时 吸附法中 SiO₂ 表面与 TiO₂ 稳定结合, 在结晶过程 中, SiO₂ 不仅能够抑制纳米 TiO₂ 晶体的生长, 也能 保持纳米 TiO₂ 的小粒径和高分散性.

对比图 3 以及表 1 的数据还可以发现, 当焙烧 温度从 500 ℃升高至 700 ℃时, TiO₂ 的晶粒粒径仅 增加了 1 nm, 但是图 3 中 700 ℃焙烧后样品的结晶 峰却非常明显. 根据对结晶过程的研究, 认为这是由 于样品中 TiO₂ 结晶度增加, 也就是锐钛矿型 TiO₂ 含量增加的结果. 在 500 ℃焙烧 5 h 后, 仅有部分 TiO₂ 形成锐钛矿型的结晶, 样品中仍有大量无定型 的 TiO₂, 因此样品中锐钛矿型 TiO₂ 的结晶峰是比较 微弱的. 当焙烧温度提高到 700 ℃时, 大量无定型 TiO₂转变成锐钛矿型, 而由于 SiO₂ 的抑制作用, 形 成晶型的 TiO₂ 仍能保持小粒径和较高分散性. 所以 在图 3 中锐钛矿 TiO₂ 的结晶峰峰强有所增加, 而其 晶粒粒径却没有明显变化.

2.1.2 光催化实验

在 25 ℃、相对湿度 8%左右的条件下,进行光催 化降解气相甲苯,并同时进行空白实验以除去空白 影响.图 4 是各个温度焙烧后的催化剂光催化降解 气相甲苯的曲线.

从降解甲苯的曲线(图 4)来看,本文采用的浓度 范围内的光催化降解反应可以用一级反应动力学方



图 4 不同温度焙烧样品光催化降解甲苯曲线 Fig.4 Degradation of toluene by samples sintered under different temperatures

程来描述,这与文献报道的在低浓度时挥发性有机 物光催化反应的动力学规律一致^[18]. 当焙烧温度为 300℃时,甲苯的浓度下降得较慢,在7h左右还不 能降解完全. 而其他三个温度焙烧后,甲苯浓度都下 降得较快,在6h左右甲苯浓度就趋于0,基本降解 完全,这就说明锐钛矿晶型形成能够大大提高TiO₂ 的光催化活性.为了能更清楚地对比出各个温度焙 烧后TiO₂的光催化活性,本文利用一级反应的数据 处理方法得到其降解反应速率常数(k_d)(图 5).

随着焙烧温度升高, TiO₂ 光催化剂活性先增加 后减小. 700 ℃焙烧后的催化剂活性最高. 焙烧温度 从 300 ℃升高至 500 ℃, 晶型从无定形到锐钛矿型 发生了转变, 光催化活性得以提高, 因此其反应速率 常数呈现急速升高. 当焙烧温度从 500 ℃增加至 700 ℃, XRD 图中样品 TiO₂ 的锐钛矿结晶峰面积有 较明显的增加, 也就是锐钛矿型 TiO₂ 的数量有了较 大的增加, 因此样品的光催化活性也随之增大, 但光 催化活性增加却没有像峰面积这么明显.





焙烧温度增加至 900 ℃时. 样品的 XRD 结晶峰 变化不明显,其晶粒粒径略为增加,但样品 900 ℃焙 烧后的光催化活性却明显降低.除了晶粒粒径少量 增加之外,作者认为活性的降低还可能由于高温焙 烧后样品团聚导致比表面积降低引起(500℃和900 ℃焙烧后, BET测得样品比表面积分别为159.6和 141.9 m²·g⁻¹). 有机物的光降解反应一般分为反应物 的扩散过程、吸附过程、表面反应过程以及产物的脱 附过程,而在气相光催化降解中,反应物的吸附过程 是决定反应速率的关键步骤.催化剂的表面积大,吸 附的反应物就多,反应的速率就快. 焙烧温度较高 时,由于团聚导致催化剂的比表面积下降,其光催化 活性也降低. 另外低温下焙烧后 TiO, 粒子的锐钛矿 结晶存在着缺陷,这种缺陷能促进光催化反应的进 行[19,20]. 而随着焙烧温度的增加, 锐钛矿结晶趋于完 整,表面缺陷结构减少,也会导致 TiO, 光催化活性 的降低.

由图 5 可以看出,当 TiO₂ 从无定型转变成锐钛 矿型时,其光催化活性有极大的提高.但 TiO₂ 的晶 粒粒径、晶型含量、比表面积以及结构缺陷等与光催 化活性的关系以及各个影响因素的权重,需要进一 步的实验工作来证明.

2.2 不同焙烧时间实验

2.2.1 焙烧时间对 TiO2 晶型和晶粒粒径的影响

从 2.1 节的结果可知, TiO₂ 的结晶过程对其光 催化效果有较大的影响. 根据 TiO₂ 的结晶过程研 究,除了焙烧温度之外,焙烧时间也是影响其结晶的 关键因素. 在 2.1 节的基础上,作者选择了 700 ℃焙 烧不同时间,得到了焙烧不同时间后样品的 XRD 图(图 6).



从图 6 可以看出, 700 ℃焙烧不同时间得到的

图 6 700 ℃焙烧不同时间后样品的 XRD 图 Fig.6 XRD patterns of samples sintered under 700 ℃ for different times

表 2 700 ℃焙烧不同时间后 TiO₂ 晶粒粒径及其 催化光降解甲苯的降解速率常数 Table 2 Grain size of TiO₂ sintered and degradation rate constant of toluene under 700 ℃ for different times

t/h	3	5	7		
<i>d</i> /nm	6.77	6.16	6.74		
$10^{3}k_{\rm d}/{\rm min}^{-1}$	13.82	15.05	15.02		

也都是纯锐钛矿型 TiO₂,没有出现金红石型.在 700 ℃焙烧温度下,即使焙烧 3 h,锐钛矿型 TiO₂ 的结晶 峰也非常明显.随着焙烧时间的增加,图中锐钛矿结 晶峰的峰面积基本不变.同样拟合 XRD 谱图中 48° 峰高的锐钛矿峰得到半高宽,然后按照 Scherrer 公 式来计算晶粒的平均粒径(表 2).考虑到用衍射峰宽 化计算晶粒粒径误差较大这一因素,可以认为 700 ℃焙烧不同时间后得到的 TiO₂ 晶粒粒径基本相同, 结合图 6 的结果可以认为,700 ℃焙烧 3 h 后得到的 TiO₂ 结晶就基本完全,增加焙烧时间对 TiO₂ 的结晶 过程影响不大.

2.2.2 光催化实验

同样在 25 ℃、相对湿度 38%左右的条件下,进 行光催化降解甲苯,并同时进行空白实验以除去空 白影响.表 3 就是经过不同焙烧时间后的催化剂降 解甲苯的光降解速率见表 2.

由图 6 及图 5 可以看出,在 700 ℃焙烧 3 h 后, 由于大量的锐钛矿型 TiO₂ 生成,催化剂已经具有和 500 ℃下焙烧 5 h 几乎相当的催化降解速率常数.而 焙烧时间增加至 5 h 时,晶型含量略有增加,因此光 催化反应速率常数也略有提高.再延长焙烧时间,结 晶峰的峰面积和晶粒粒径都基本不变,对提高催化 剂的活性不会有帮助.



图 7 700 ℃焙烧 5 h 后吸附法样品和 P25 的 XRD 图 Fig.7 XRD patterns of samples by APRT and P25



and P25

2.3 与 P25 的比较

2.3.1 晶型与晶粒粒径的比较

吸附法得到的样品中 TiO₂ 以纯锐钛矿型存在, 而 P25 中金红石和锐钛矿型并存,其中锐钛矿型 TiO₂ 相对含量为 75%,其中锐钛矿晶型的 TiO₂ 的 平均晶粒粒径为 24 nm.

2.3.2 光催化活性的比较

在相同 TiO₂含量下,对比催化活性最高的 700 ℃下焙烧 5 h 的吸附法样品与 P25 光降解甲苯曲线 (图 8),可以看出两者在相同时间内降解甲苯的能力 几乎一样,700 ℃下焙烧 5 h 的纳米 TiO₂/SiO₂ 光催 化剂降解速率稍高于 P25.

但是当催化剂用量都减少一半时,可以看出吸附法得到的催化剂的光催化活性明显高于 P25(如图 9),两者的光降解速率常数以及单位 TiO₂ 的光降解速率常数列于表 3.表 3 的数据表明, P25 反应速率常数变化与其用量的变化相同,说明在高、低催化



0.3 g photo-catalyst

表	3 吸附法样品和 P25 的光降解速率常数
Table 3	Degradation rate constant of APRT sample
	and n25

and p25							
	0.6 g photo-catalyst		0.3 g photo-catalyst				
	APRT sample	P25	APRT sample	P25			
$10^{3}k_{\rm d}/{\rm min}^{-1}$	14.98	14.49	10.35	7.24			
$10^{3}k'_{d}/(\min^{-1} \cdot g^{-1})$	71.13	69.00	94.09	65.82			

 k'_{d} : degradation rate constant of unit mass of TiO₂

剂浓度下,其动力学均较好地反映了催化剂的活性. 而对于吸附法制备的 TiO₂,其反应常数变化与用量 变化不一致.为更好描述催化剂用量的影响,我们先 把该反应速率常数换算为以单位质量催化剂为基准 的速率常数.从表 3 中的换算结果可以看出,对于吸 附法制备的催化剂,催化剂用量减半,单位质量催化 剂上的反应速率增大,说明在催化剂用量较多时,部 分催化剂没有完全发挥作用.这可能是由于吸附法 制备的催化剂粒径小、分散性好,平板表面无法铺展 所有的光催化剂,部分下层的催化剂不能得到充分 的紫外光照射.而粒径较大的 P25 在平板表面能得 到全部铺展,因而全部的 P25 都能利用紫外光进行 光降解.

从紫外光利用方面来说,当催化剂用量较小时, P25 催化剂不能全部铺满平板表面,因而不能有效 利用照射在平板表面的所有紫外光,此时催化剂的 粒径和分散性就决定了有效利用紫外光的面积.吸 附法制备的催化剂由于粒径小、分散性好,在平板表 面铺展的面积大,对紫外光的利用率就较高.

3 结 论

 (1) 当焙烧温度超过 500 ℃时,吸附法得到的 TiO₂ 均维持纯锐钛矿晶型,即使焙烧温度高达 900
 ℃. 锐钛矿型 TiO₂ 含量随着焙烧温度增加而增加, 但其晶粒粒径则随焙烧温度变化不大.

(2) 锐钛矿晶型的出现以及含量的增加都会大 大影响 TiO₂ 的光催化活性. 700 ℃焙烧 5 h 后, 催化 剂的光催化活性最高, 而焙烧温度继续增加则会导 致 TiO₂ 光催化活性的降低. (3) 700 ℃焙烧3 h后样品中就出现了较大量锐 钛矿晶型TiO₂,随着焙烧时间增加,晶型含量以及晶 粒粒径都变化不大,因此其光催化活性也相差不大.

(4) 对单位质量 TiO₂ 的光催化反应速率常数, 吸附法催化剂高于 P25 光催化剂.

References

- Jeong, J.; Sekiguchi, K.; Lee, W.; Sakamoto, K. J. *Photochem. Photobio. A*, **2005**, **169**(3): 279
- 2 Danion, A.; Disdier, J.; Guillard, C.; Paisse, O.; Jaffrezic-Renault, N. *Appl. Catal. B*, **2005**, **62**(3–4): 274
- Coleman, H. M.; Eggins, B. R.; Byrne, J. A. Appl. Catal. B, 2000, 24(1): L1
- 4 Hidalgo, M.C.; Bahnemann, D. Appl. Catal. B, 2005, 61(3-4): 259
- 5 Hoffmann, M. R.; Martin, S. T.; Choi, W.; Bahnemann, D. W. *Chem. Rev.*, **1995**, **95**(1): 69
- 6 Dina, F.; John, K.; David, A. J. Phys. Chem., 1989, 93(15): 5851
- 7 Dekany, I.; Turi, L.; Kiraly, Z. Appl. Clay Sci., 1999, 15(20): 221
- 8 Dekany, I.; Turi, L.; Suzucs, A. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, **1998**, **141**(3): 397
- 9 Jiang, X.; Wang, T.; WANG, Y. W. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 2004, 234(1-3): 9
- Wang, T.; Jiang, X. J. Chem. Ind. Eng., 2003, 24(12): 1779
 [王 挺,蒋 新. 化工学报, 2003, 24(12): 1779]
- 11 Jiang, X.; Wang, T. Environ. Sci. Technol., 2007, 41(12): 4441
- 12 Jaeger, C. D.; Bard, A. J. J. Phys. Chem., 1979, 83(24): 3146
- Loddo, V.; Marci, G.; Martin, C.; Palmisano, L.; Rives, V.;
 Sclafani, A. *Appl. Catal. B*, **1999**, **20**(1): 29
- Zhang, Q. H.; Gao, L.; Guo, J. J. Euro. Ceram. Soc., 2000, 20(12): 2153
- 15 Jiang, X.; Chen, X. M. J. Crystal Growth, 2004, 270(3-4): 547
- Belhekar, A. A.; Awate, S. V.; Anand, R. *Catal. Commun.*, 2002, 3 (10): 453
- 17 Zhang, Q. H.; Gao, L.; Zheng, S. Chem. Lett., 2001, 11(1): 1124
- 18 Kim, S. B.; Hong, S. C. Appl. Catal. B, **2002**, **35**(4): 305
- 19 Gao, L.; Zhang, Q. H.; Zheng, S. Nano TiO₂ photocatalytic materials and application. Beijing: Chemical Industry Press, 2002: 39, 44
 [高 濂, 张青红, 郑 珊. 纳米氧化钛光催化材料及应用. 北京: 化学工业出版社, 2002: 39, 44]
- 20 Boer, K. W. Survey of semiconductor physics. New York: Van Nostrand Reinhold, 1990: 249